

КТ3129

кремниевый эпитаксиально-планарный
биполярный р-п-р транзистор

Назначение

Кремниевый эпитаксиально-планарный биполярный р-п-р транзистор. Предназначен для использования в низкочастотных устройствах радиоэлектронной аппаратуры, изготавливаемой для народного хозяйства.

Зарубежные прототипы

- BC857A прототип КТ3129Б9
- BC858A прототип КТ3129В9
- BC858В прототип КТ3129Г9

Особенности

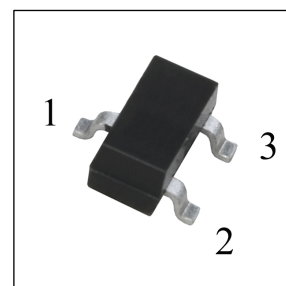
- рабочий температурный диапазон от - 60 до + 85 °С

Обозначение технических условий

- аАО.336.447ТУ / 02

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-46А (SOT-23)



Назначение выводов

Вывод	Назначение
№1	Коллектор
№2	База
№3	Эмиттер

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ3129

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо гр.	В	Iк=10 мА, Iб=0	-15	-40
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Uкб=-20-50В, Iэ=0		-1,0
Статический коэффициент передачи тока	h _{21э}		Uкб=-5В, Iэ=-2мА	30	500
Емкость коллекторного перехода	Ск	пФ	Uкб=-5В, Iэ=0, f=10МГц		12
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ нас	В	Iк=-10мА, Iб=-1мА		-0,2
Напряжение насыщения база-эмиттер	Uбэ нас	В	Iк=-10мА, Iб=-1мА		-1,3
Граничная частота коэффициента передачи тока	fгр.	МГц	Uкб=-5В, Iэ=-10мА	200	

Таблица 2. Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации КТ3129

Параметры	Обозначение	Единица изм.	Значение
Напряжение коллектор-база	Uкб max	В	-20-50
Напряжение коллектор-эмиттер (Rбэ=1кОм)	Uкэг max	В	-20-40
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	-5
Постоянный ток коллектора	Iк max	мА	-100
Импульсный ток коллектора	Iки max	мА	-200
Рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	мВт	75
Температура перехода	Tj	°C	125

Таблица 3. Классификация параметров КТ3129

Параметры	КТ3129А9	КТ3129Б9	КТ3129В9	КТ3129Г9	КТ3129Д9
Uкб max, В	50	50	30	30	20
Uкэг max, В	40	40	20	20	20
h _{21э}	30-120	80-250	80-250	200-500	200-500

